

事業概況(設備投資額・研究開発費)

設備投資額

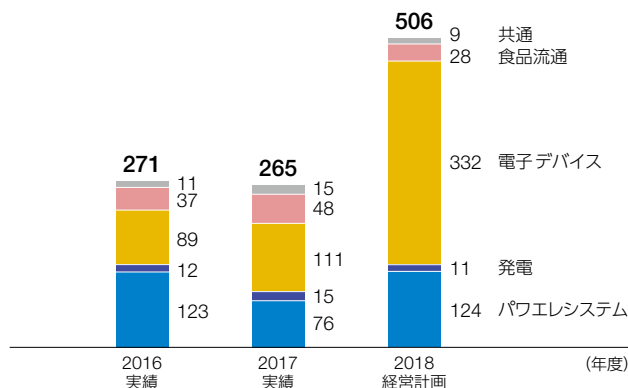
現地設計・地産・地消に加え、注力分野への集中投資を基本に設備投資を行っています。

2017年度は、電子デバイスでは、SiCパワー半導体などの新製品開発に対応した生産設備を導入し、食品流通では、中国自動販売機の生産能力拡大に向け、中国の大連・第二工場を竣工しました。

2018年度は、電子デバイスでは、パワー半導体事業の拡大に向けた生産能力の増強ならびに自動車分野向けや産業向けパワー半導体、SiCパワー半導体などの新製品開発に対応した生産設備への投資を推進します。また、パワーエレクトロニクスでは、タイの生産拠点(FMT*)において、盤システム工場の建設に着手します。

* 富士電機 マニュファクチャリング(タイランド)社

設備投資額
(億円)



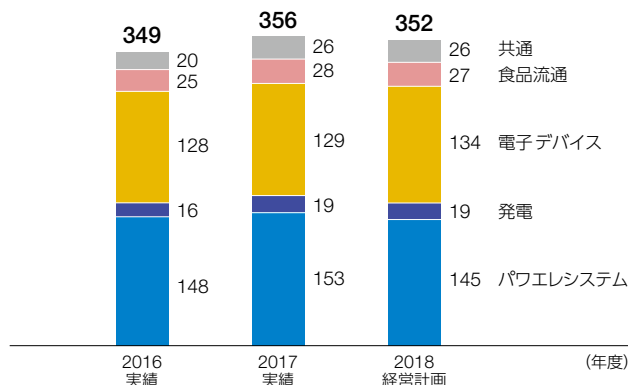
研究開発費

競争力のある付加価値商材の開発強化を基本に研究開発への投資を行っています。

2017年度は、強いコンポーネントとシステムを創出する開発に注力しました。電子デバイスでは、搭載機器の大幅な省エネに貢献するSiCパワー半導体を、パワーエレクトロニクスでは、自動車向けに当社のFAシステムを適用したタイヤ試験装置を開発しました。さらに、設備の「診断・分析」「予測」を行い、お客様のエネルギー利用や操業の最適化に貢献するIoTプラットフォームの開発に注力しました。

2018年度も引き続き、研究開発費の約40%を占める電子デバイスでは、SiCパワー半導体や自動車分野向けパワー半導体、同じく約40%を占めるパワーエレクトロニクスでは、SiCを適用したパワーエレクトロニクス製品などの研究開発に取り組めます。また、全社的に、IoTに対応した機器・システムの開発を推進します。

研究開発費*
(億円)



* 研究開発費をテーマに応じてセグメントに分類したもので、決算短信記載の数値とは異なります。